

LNA2904L

GaAs Infrared Light Emitting Diode

For optical control systems

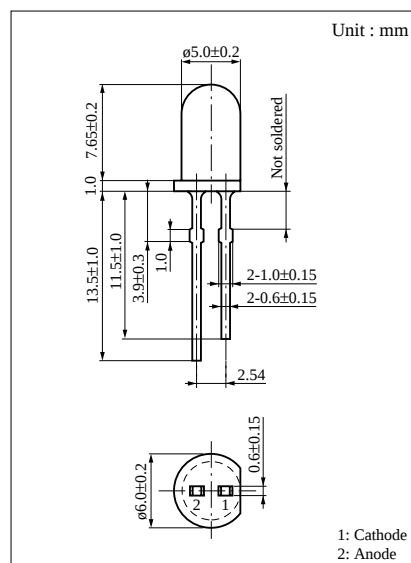
Features

- High-power output, high-efficiency : $I_e = 10 \text{ mW/sr (min.)}$
- Emitted light spectrum suited for silicon photodetectors
- Good radiant power output linearity with respect to input current
- High center radiant intensity
- Transparent epoxy resin package

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

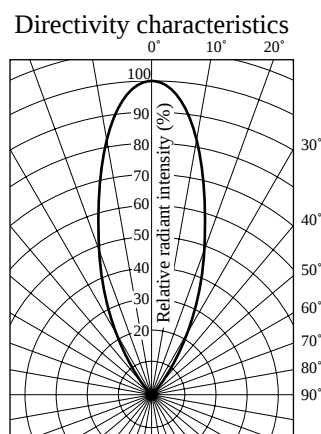
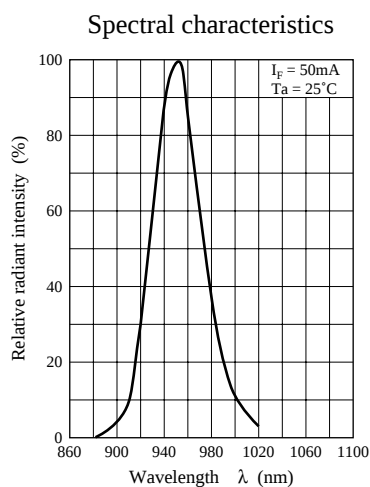
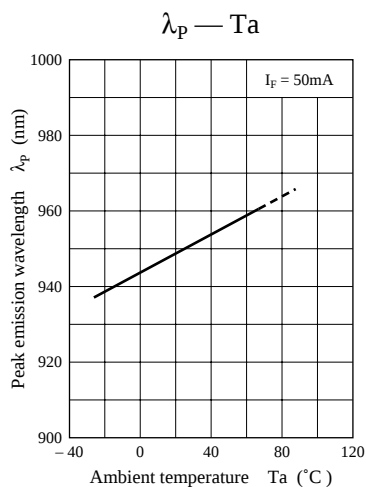
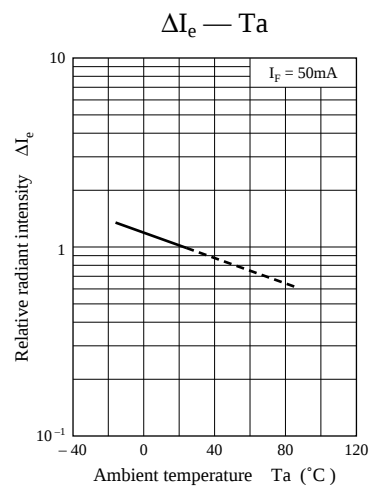
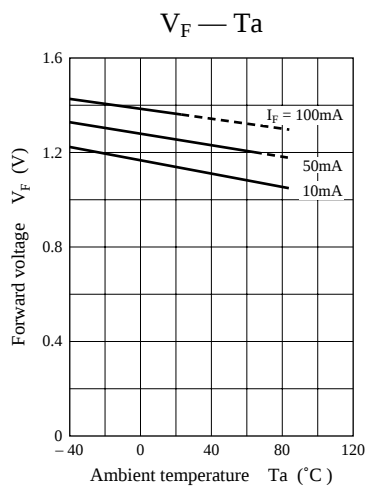
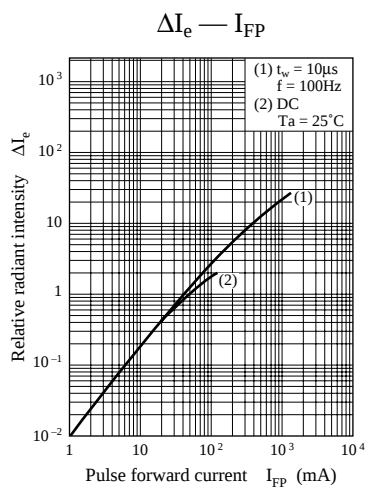
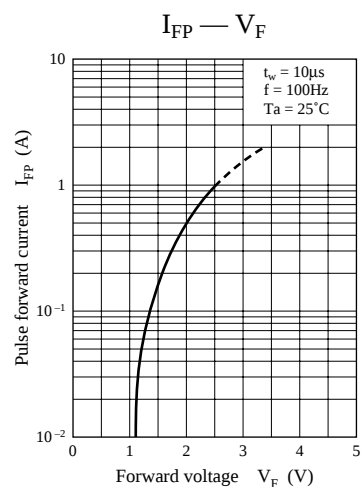
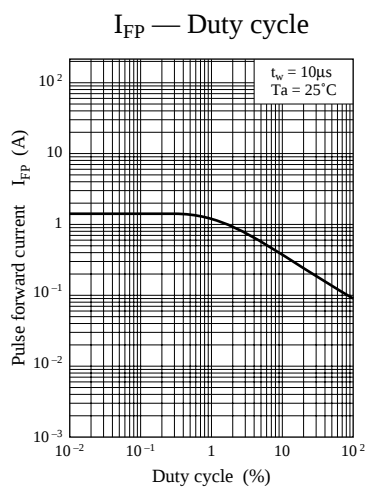
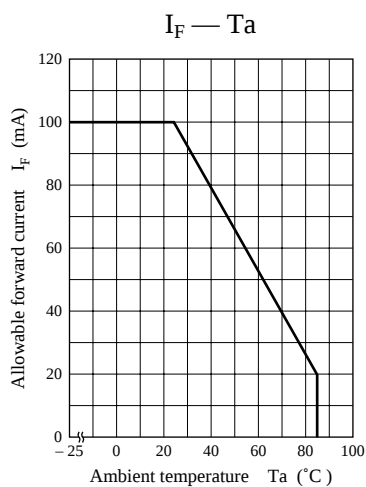
Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Power dissipation	P_D	160	mW
Forward current (DC)	I_F	100	mA
Pulse forward current	I_{FP}^*	1.5	A
Reverse voltage (DC)	V_R	3	V
Operating ambient temperature	T_{opr}	-25 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$

* $f = 100 \text{ Hz}$, Duty cycle = 0.1 %



Electro-Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Center radiant intensity	I_e	$I_F = 50 \text{ mA}$	10			mW/sr
Peak emission wavelength	λ_p	$I_F = 50 \text{ mA}$		950		nm
Spectral half band width	$\Delta\lambda$	$I_F = 50 \text{ mA}$		50		nm
Forward voltage (DC)	V_F	$I_F = 100 \text{ mA}$		1.35	1.6	V
Reverse current (DC)	I_R	$V_R = 3 \text{ V}$			10	μA
Capacitance between pins	C_t	$V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$		50		pF
Half-power angle	θ	The angle in which radiant intensity is 50%		20		deg.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.